



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 442 002 A1**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 90102816.7

51 Int. Cl.⁵: H01L 33/00, H01S 3/06

22 Anmeldetag: 13.02.90

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
21.08.91 Patentblatt 91/34

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

71 Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
W-8000 München 2(DE)

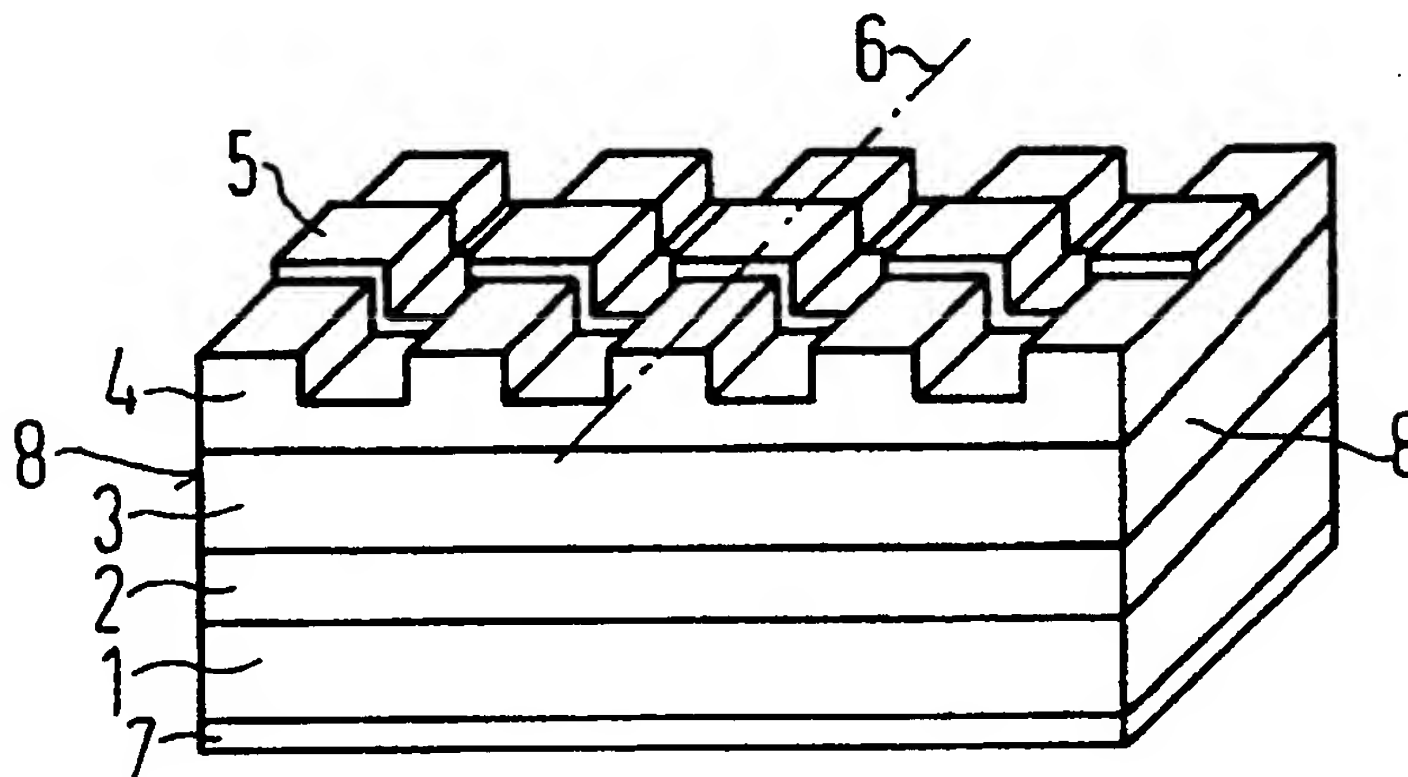
72 Erfinder: Köck, Anton, Dr.
Grimmelsenstrasse 19
W-8000 München 81(DE)
Erfinder: Gornik, Erich, Prof.
Knöbelstrasse 4
W-8000 München 22(DE)

54 Strahlungserzeugendes Halbleiterbauelement.

57 Oberflächenemittierende Leuchtdiode, bei der ein erster Kontakt (5) schichtartig auf eine parallel zu der Ebene einer für Strahlungserzeugung vorgesehene aktiven Schicht (3) und in ausreichender Nähe zu dieser aktiven Schicht (3) verlaufende Oberfläche

aufgebracht ist und diese Oberfläche derart gitterartig strukturiert ist, daß im Betrieb des Bauelementes eine stark gerichtete Abstrahlung bewirkende Oberflächenplasmon polaritonen auf der freien Oberfläche des ersten Kontaktes (5) angeregt werden.

FIG 7



EP 0 442 002 A1

STRAHLUNGSERZEUGENDES HALBLEITERBAUELEMENT

Die Erfindung betrifft ein strahlungserzeugendes Halbleiterbauelement nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

LEDs und Laserdioden stellen beispielsweise für die Kommunikation über optische Glasfaserkabel die interessantesten Lichtquellen dar. Die Vorteile, die Laserdioden im Vergleich zu LEDs aufweisen, sind eine wesentlich höhere externe Quantenausbeute (d. h. Zahl der emittierten Photonen pro Elektron) und damit höhere Leistung, eine deutlich kleinere Linienbreite und eine definierte Polarisation des emittierten Lichtes.

Im Hinblick auf verschiedene technische Anwendungen weisen LEDs allerdings eine Reihe von wesentlichen Vorteilen gegenüber Laserdioden auf. Die emittierte Leistung ist bei LEDs weniger temperaturabhängig, so daß LEDs im praktischen Einsatz deutlich stabiler sind als Laserdioden. LEDs können bei viel höheren Temperaturen betrieben werden und benötigen keinen aufwendigen Regelkreis. Zudem sind LEDs viel einfacher herzustellen und besitzen eine höhere Lebenserwartung.

Zur Zeit werden von verschiedenen Herstellern LEDs im Materialsystem AlGaAs/GaAs angeboten, die ausschließlich bei Verwendung einer Linse (teilweise werden die LEDs in Kunststofflinsen eingegossen) eine mehr oder weniger gerichtete Abstrahlung aufweisen. Derzeit liegen bei handelsüblichen LEDs mit Linse die Quantenausbeute in der Größe von 1 bis 2% und die Strahldivergenz (d. h. der volle Winkel des halben Strahlungsmaximums, engl. full angle at half maximum) bei etwa 10° bis 15° bei einem Linsendurchmesser von 4,7 mm und bei 20° bis 60° bei Verwendung von kleineren Linsendurchmessern.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein einfach herzustellendes strahlungsemitterndes Halbleiterbauelement anzugeben, das bei hoher Quantenausbeute eine geringe Strahldivergenz aufweist.

Diese Aufgabe wird mit dem Halbleiterbauelement mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Weitere Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Es erfolgt eine Beschreibung von erfindungsgemäß aufgebauten Halbleiterbauelementen, insbesondere Leuchtdioden, anhand der Figuren 1 bis 8, in denen jeweils eine Ausführungsform dieses erfindungsgemäßen Bauelementes in Schnittauf sicht dargestellt ist. Die Figuren 9 bis 11 zeigen jeweils ein erfindungsgemäßes Bauelement in Aufsicht mit jeweils unterschiedlicher Anordnung der Emissionsbereiche. Fig. 12 zeigt ein Diagramm mit typischen Richtcharakteristiken.

Der erfindungsgemäße Aufbau basiert auf ei-

nem neu entdeckten Emissionsmechanismus über Anregung und Emission von Oberflächenplasmonpolaritonen. Oberflächenplasmonpolaritonen sind transversal elektrische (TE) oder transversal magnetische (TM) Oberflächenmoden, die sich an der Grenzfläche zweier verschiedener Medien ausbreiten können. Bei geeigneter periodischer Strukturierung der Grenzfläche können diese Moden mit elektromagnetischen Wellen angeregt werden. Unter Anwendung dieses Emissionsmechanismus lassen sich die Eigenschaften von lichtemittierenden Dioden (LEDs und Laserdioden) grundlegend und entscheidend verbessern. Bei herkömmlichen LEDs auftretende Verlustmechanismen, die deren Wirkungsgrad limitieren, werden damit umgangen und die Verluste reduziert. Bei gleichzeitig deutlich verringerter Linienbreite wird eine drastische Erhöhung der externen Quantenausbeute und eine gerichtete Abstrahlung definierter Polarisation mit einer Strahldivergenz von weniger als 6° erreicht, wobei auf die Verwendung einer Linse verzichtet werden kann.

Der Unterschied zu herkömmlichen LEDs liegt bei dem erfindungsgemäßen Aufbau in einer periodischen Strukturierung der Oberfläche des Halbleitermaterials, die mittels üblicher Technologie hergestellt wird. Diese Gitterstruktur kann im Längsschnitt z. B. sinusförmiges, dreieckförmiges oder rechteckförmiges Profil haben, es sind aber auch andere Oberflächenprofile mit Gitterstruktur möglich. Ein auf diese Strukturierung aufgebracht er semitransparenter Metallfilm (erster Kontakt 5 in Fig. 1) ermöglicht die Anregung von Oberflächenplasmonpolaritonen an der Oberfläche dieses Metallfilms.

Der Metallfilm kann gleichzeitig als ohmscher Frontkontakt dienen (wie in Fig. 1 dargestellt); der Metallfilm für die Emission von Oberflächenplasmonpolaritonen kann auch zusätzlich zu der ohmschen Kontaktmetallisierung ausgeführt sein. Die Oberflächenplasmonpolaritonen werden angeregt durch bei Betrieb des Bauelementes in einer aktiven Zone 3 generierte Photonen, deren H-Feldvektor parallel zur der in Fig. 1 eingezeichneten Achse 6 orientiert ist. Die angeregten Oberflächenplasmonpolaritonen emittieren aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften Licht definierter Polarisation (p-Polarisation, d. h. H-Feldvektor parallel zu der Achse 6) in eine von der Gitterperiode abhängige Richtung. Diese Abstrahlrichtung kann daher durch Variation der Gitterperiode beliebig eingestellt werden. Für eine vertikale Emission muß die Gitterperiode (Gitterkonstante) etwa gleich sein der zu emittierenden Wellenlänge. Genau muß gelten, daß die Gitterperiode gleich dem Produkt der zu emit-

tierenden Wellenlänge und $\sqrt{1+1/\epsilon}$ (ϵ = Dielektrizitätskonstante des Metalls) ist, damit diese zu emittierende Wellenlänge vertikal abgestrahlt wird. Der Öffnungswinkel der Strahlung (Strahldivergenz) ist dabei wesentlich kleiner als bei herkömmlichen oberflächenemittierenden LEDs ohne periodische Strukturierung der Oberfläche.

Wird auf den Metallfilm zusätzlich ein Dielektrikum (dessen Dicke typischerweise nicht größer als 5 μm) aufgebracht, so ist die Ausbreitung von TE_i - und TM_i -Moden i -ter Ordnung möglich, wobei die Zahl der Moden und der maximale Index i von der Dicke des Dielektrikums abhängt: Mit zunehmender Dicke nimmt die Zahl der Moden in der Reihenfolge TM_0 , TE_0 , TM_1 , TE_1 ,... usw. zu, d. h. es breiten sich zusätzlich zur TM_0 -Mode (bei Fehlen des Dielektrikums) weitere Moden aus. In dieser Notation ist die TM_0 -Mode identisch mit dem Begriff Oberflächenplasmon. Der Oberbegriff für alle bei Vorhandensein des Dielektrikums auftretenden Moden (TM_i , TE_i) ist Oberflächenplasmonpolariton.

An der Grenzfläche zwischen dem Metallfilm und der Luft kann sich die TM_0 -Mode ausbreiten, die durch p-polarisiertes Licht (H-Feldvektor parallel zu Achse 6) angeregt werden kann. Entsprechend kann sich an der Grenzfläche zwischen dem zusätzlich aufgetragenen Dielektrikum und der Luft die TE_0 -Mode ausbreiten, die durch s-polarisiertes Licht (E-Feldvektor parallel zu Achse 6) angeregt werden kann. Bei besonders vorteilhaften Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Bauelements werden vorrangig die TM_0 -, die TE_0 - und die TM_1 -Mode von Bedeutung sein.

Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 sind auf einem n-dotierten Substrat 1 nacheinander übereinander aufgewachsen eine n-dotierte erste Confinementschicht 2, eine p-dotierte aktive Schicht 3 und eine p-dotierte zweite Confinementschicht 4. Das Substrat 1 und die aktive Schicht 3 sind z. B. GaAs, die Confinementschichten 2, 4 $\text{Al}_{0,3}\text{Ga}_{0,7}\text{As}$. Eingezeichnet sind weiter ein erster Kontakt 5 und ein zweiter Kontakt 7 zum Anlegen des Betriebsstromes. Die Vorzeichen der Dotierung können auch umgekehrt sein, und es kommen andere für Leuchtdioden oder Laserdioden gebräuchliche Materialsysteme in Frage. Wesentlich für den erfindungsgemäßen Aufbau ist eine gitterförmige Strukturierung der Oberfläche der zweiten Confinementschicht 4, die ihrerseits aus verschiedenen Schichtkomponenten zusammengesetzt sein kann. Diese periodische Strukturierung der Oberfläche, ohne die die Anregung und Emission von Oberflächenplasmonpolaritonen nicht möglich ist, überträgt sich auf den dünnen schichtartig aufgetragenen ersten Kontakt 5 aus Metall. Auf dessen Oberfläche, d. h. Grenzfläche zur Luft werden die Oberflächenplasmonen angeregt, die in einen durch die Energie- und Impulsgleichungen bestimmten Win-

kel, der von der Gitterperiode abhängt, abgestrahlt werden. Statt des rechteckigen Längsschnittprofils der einzelnen Gitterstege wie in Fig. 1 kommt auch ein gewelltes, z. B. sinusförmiges Gitterprofil entsprechend Fig. 2 oder ein symmetrisches oder asymmetrisches dreieckiges Gitterprofil wie in Fig. 3 in Frage. Wesentlich ist die periodische Strukturierung.

Für die Effektivität der Anregung und Emission von Oberflächenplasmonen sind die Dicke d_4 der zweiten Confinementschicht 4, die Gitterperiode L_g (Gitterkonstante), die Gitterhöhe h , d. h. die Höhe der aufgetragenen Oberflächenstrukturierung (Amplitude der Schichtdickendifferenz) dieser zweiten Confinementschicht 4 und das Verhältnis von Gitterperiode L_g zu Gitterhöhe h von entscheidender Bedeutung. Der Abstand der aktiven Schicht 3 von der Metalloberfläche (d. h. der Grenzfläche Metall/Luft) des ersten Kontaktes 5 ($d_4 + d_5$, wobei d_5 die Dicke des ersten Kontaktes 5 ist) ist für den Kopplungsgrad zwischen den in dieser aktiven Schicht 3 erzeugten Photonen und den auf der Metalloberfläche angeregten Oberflächenplasmonen wesentlich. Durch eine Verringerung des Abstandes ($d_4 + d_5$) der aktiven Schicht 3 von der Metalloberfläche läßt sich daher der Wirkungsgrad der Leuchtdiode steigern. Vorteilhafte Abmessungen sind: Dicke d_4 der zweiten Confinementschicht 4 maximal 3 μm , Gitterhöhe h maximal 1 μm , Dicke d_5 des ersten Kontaktes 5 maximal 2 μm .

Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem die Oberfläche der zweiten Confinementschicht 4 mit einem Kreuzgitter strukturiert ist. Die Abstrahlung erfolgt dann mit zwei senkrecht aufeinanderstehenden Polarisationsrichtungen. Dadurch läßt sich die Quantenausbeute weiter erhöhen. Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel mit einem zu dem in Fig. 4 gezeigten Kreuzgitter reziproken Gitter. Fig. 6 hat eine durch Zylinder, die periodisch angeordnet sind, (sogenannte Quantum-Dots) strukturierte Oberfläche. Wesentlich ist, daß die Oberfläche der zweiten Confinementschicht 4 in zwei senkrecht aufeinanderstehenden Richtungen periodisch strukturiert ist. Die Bezeichnung Gitter ist in einem allgemeinen Sinn aufzufassen. Ebenso wie die in den Figuren dargestellten Gitterstrukturen mit Rechteckprofil kommen Kreuzgitter mit sinusförmigen oder dreieckigen Quer- bzw. Längsschnitten in Frage.

Fig. 7 zeigt eine Anwendung auf eine Laserdiode. Bei diesem Aufbau ist ein streifenförmiger erster Kontakt 5 auf eine Gitterstruktur der Oberfläche der zweiten Confinementschicht 4 aufgebracht. Dieser streifenförmige erste Kontakt 5 bewirkt eine laterale Begrenzung (Gewinnführung) der in der aktiven Schicht 3 generierten Strahlung, die zwischen den Resonatorenflächen 8 reflektiert wird. Die zwischen diesen Resonatorenflächen 8, die

zusätzlich verspiegelt sein können, reflektierten Photonen regen Oberflächenplasmonpolaritonen an der freien, d. h. an die Luft grenzenden Oberseite des ersten Kontaktes 5 an. Diese Oberflächenplasmonpolaritonen zerfallen unter Aussendung von Strahlung, die wegen der schmalen Linienbreite der Laserstrahlung extrem gerichtet emittiert wird. Der Auskopplungsgrad wird dabei durch den Abstand der aktiven Schicht 3 von der mit dem Metallstreifen versehenen Oberfläche der zweiten Confinementschicht 4 bestimmt und kann je nach Abstand (ca. 0,1 bis 2 μm) beliebig variiert sein.

Bei einer Laserdiode, die entsprechend vorliegender Erfindung aufgebaut ist, kommt auch jede der vorstehend erwähnten Gitterstrukturen in Frage. In Fig. 8 ist eine entsprechende Laserdiode mit etwa sinusförmigem Gitterprofil dargestellt. Der den ersten Kontakt 5 bildende Metallstreifen ist mit einer Dielektrikumschicht 10 zur Anregung von TE-Moden versehen. Die Resonatorendflächen sind mit Spiegeln 9 versehen. Auch bei einer Laserdiode kommen verschiedene Gitterprofile in Frage, wobei jeweils eine periodische Strukturierung in Längsrichtung des Lasers wesentlich ist. Das Ausführungsbeispiel entsprechend Fig. 7 bzw. Fig. 8 läßt sich auf eine Anordnung mehrerer miteinander verkoppelter Laser (Laserdiodenarray) erweitern.

Strahlung kann von denjenigen Bereichen der Oberfläche des Halbleitermaterials emittiert werden, in denen eine periodische Strukturierung dieser Oberfläche mit einem semitransparenten Metallfilm versehen ist. In den beschriebenen Ausführungsbeispielen diente jeweils der erste Kontakt 5 gleichzeitig als ohmscher Kontakt für den Anschluß des Betriebsstromes und als dieser semitransparente Metallfilm zur Erzeugung von Oberflächenplasmonpolaritonen. Statt dieser einfachen Ausführungsformen ist es ebenso möglich, den Metallkontakt stellenweise als semitransparenten Metallfilm und im übrigen als entsprechend dicker aufgebracht ohmschen Kontakt auszubilden. Eine Abstrahlung erfolgt dann in dem Bereich, in dem der semitransparente Metallfilm auf der periodischen Strukturierung (gitterartige Strukturierung) der zweiten Confinementschicht 4 aufgebracht ist. Diese periodische Strukturierung ihrerseits braucht nicht die gesamte freie Oberfläche der zweiten Confinementschicht 4 zu bedecken. Es ist daher möglich, durch eine Begrenzung dieser periodischen Strukturierung den Bereich der Strahlungsemission zu begrenzen. Eine möglicherweise zusätzlich aufgebrachte Dielektrikumschicht 10 braucht ebenfalls nicht den gesamten Metallfilm oder den gesamten mit diesem Metallfilm bedeckten strukturierten Bereich zu bedecken, sondern kann auf Teilbereiche dieses Bereiches begrenzt sein.

In Fig. 9 bis 11 sind die für die Abstrahlung vorgesehenen Oberseiten dreier Ausführungsbei-

spiele in Aufsicht dargestellt. Es handelt sich jeweils um Laserdioden mit Spiegeln 9, deren Oberseite eine in den Figuren durch eine sprossenartige Schraffur dargestellte periodische Strukturierung aufweist. Auf diese Oberseite ist jeweils eine Metallschicht aufgebracht, die einen semitransparenten Metallfilm 50 auf dieser gitterartigen Struktur und einen gegebenenfalls dicker aufgetragenen ohmschen Kontakt 51 umfaßt. Der Bereich, in dem eine Dielektrikumschicht 10 zusätzlich auf die Oberseite des Metallfilms aufgebracht ist, ist mit einer strichpunktierten Umgrenzung eingezeichnet. In Fig. 9 ist der Bereich der Strahlungsemission auf ein in der Mitte des Bauelementes befindliches Fenster begrenzt. Dieser Bereich ist außerdem vollständig mit der Dielektrikumschicht 10 bedeckt. In Fig. 10 erfolgt die Strahlungsemission über die gesamte Laserlänge, während die Dielektrikumschicht 10 nur in einem Teilbereich aufgebracht ist. In Fig. 11 ist die periodische Strukturierung ganzflächig aufgebracht, der semitransparente Metallfilm 50 befindet sich aber nur in einem streifenförmigen Bereich, während der ohmsche Kontakt 51 einen daran angrenzenden Teilbereich der Oberfläche bedeckt. Auch in dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 11 kann eine Dielektrikumschicht in einem frei wählbaren Bereich aufgebracht werden. Auf diese Weise ergibt sich ein weiterer Spielraum für die Anordnung der für Strahlungsemission und der für elektrische Kontaktierung vorgesehenen Bereiche.

Für den semitransparenten Metallfilm eignen sich besonders die Metalle Gold, Silber und Aluminium; es ist aber grundsätzlich jedes Metall verwendbar. Die einschränkende Bedingung, daß die Frequenz des Elektronenplasmas des Metalles größer als die Frequenz der zu emittierenden Strahlung sein muß, ist in allen praktischen Fällen für beliebige Metalle erfüllt.

Fig. 12 zeigt ein Diagramm mit dem Fernfeldmuster bei einer Wellenlänge von 867 nm. Eine ohne Strukturierung der Oberfläche hergestellte LED hat ohne Verwendung einer Linse das Fernfeldmuster entsprechend Kurve c in Fig. 12. Die Emission erfolgt praktisch ungerichtet und völlig unpolarisiert. Bei einer strukturierten LED entsprechend vorliegender Erfindung wird über Anregung und Emission von Oberflächenplasmonen der Anteil mit H-Feldvektor längs der Achse 6 stark verstärkt ausgekoppelt und extrem gerichtet abgestrahlt. Das resultierende Fernfeldmuster bei einer mit der Gitterkonstanten 850 nm modulierten LED ist als Kurve a in Fig. 12 dargestellt. Die Emission erfolgt ohne Verwendung einer Linse mit einer Strahldivergenz von weniger als 6° in einen Winkel von $\pm 1,3^\circ$. Das Fernfeldmuster der senkrecht dazu liegenden Polarisationskomponente ist gleich dem einer unstrukturierten LED und wird somit

durch Kurve c dargestellt. Obwohl nur das Licht der einen Polarisationskomponente verstärkt ausgekoppelt wird, ist die insgesamt externe Quantenausbeute im Vergleich zur herkömmlichen, unstrukturierten LED um 51 % auf 1,51 % bei diesem Ausführungsbeispiel gestiegen, während gleichzeitig die Linienbreite im Emissionsmaximum ($\pm 1,3^\circ$ von der Hauptachse) um 26 % auf 27,5 nm gesunken ist. Das Fernfeldmuster einer mit der Gitterperiode 1024 nm modulierten LED ist durch Kurve b dargestellt und demonstriert die über die Periode des Oberflächengitters beinahe beliebig einstellbare Abstrahlcharakteristik.

Vorteile der erfindungsgemäßen LED sind insbesondere eine Verbesserung des Wirkungsgrades und der Abstrahlcharakteristik. Oberflächenstrukturierte LEDs entsprechend vorliegender Erfindung strahlen ohne Verwendung aktiver optischer Komponenten extrem gerichtet ab. Die bisher damit erzielte Strahldivergenz liegt weit unter der herkömmlicher LEDs, die obendrein voluminöse Linsen benötigen, um gerichtet zu emittieren.

Die Quantenausbeute von LEDs mit Oberflächenstrukturierung wird drastisch erhöht, da die einer herkömmlichen LED eigenen und normalerweise nicht vermeidbaren Fresnel- und Reflexionsverluste verringert werden. Einerseits können nämlich auch Photonen, deren Emissionswinkel größer als etwa 16° ist und die normalerweise in das Substrat totalreflektiert werden, Oberflächenplasmonen anregen und über diese Oberflächenplasmonen als Strahlung ausgekoppelt werden. Andererseits sinkt der Anteil der an der LED/Luft-Grenzfläche zurückreflektierten Photonen stark ab, da in Oberflächenplasmonenresonanz die Reflexion minimal wird. Photonen, die Oberflächenplasmonen anregen, können somit im Idealfall nahezu verlustfrei aus dem Substrat ausgekoppelt werden.

Aufgrund der schmalen Anregungslinie von Oberflächenplasmonpolaritonen sinkt im Maximum der emittierten Intensität die Linienbreite deutlich ab.

Der erfindungsgemäße Aufbau ist nicht auf das Materialsystem AlGaAs/GaAs beschränkt. Er kann ganz allgemein auf Leuchtdioden und Laserdioden beliebiger Emissionswellenlängen und Materialzusammensetzung angewendet werden. Da die Dämpfung der Oberflächenplasmonpolaritonen mit zunehmender Wellenlänge abnimmt, ist der Anregungs- und Emissionsmechanismus der Oberflächenplasmonpolaritonen speziell im Infraroten besonders effektiv. Es muß lediglich die Gitterperiode (Gitterkonstante) der Wellenlänge angepaßt werden.

Da die Anregungseffizienz von Oberflächenplasmonpolaritonen durch in der aktiven Schicht generierte Photonen in erster Linie durch den Abstand dieser aktiven Schicht von der periodisch

strukturierten Oberfläche bestimmt wird, ist die Effizienz des Emissionsmechanismus weitgehend unabhängig vom Typus der LED bzw. Laserdiode. Daher kann das Emissionsverfahren durch Oberflächenplasmonpolaritonen ganz allgemein Anwendung finden bei Aufbauten mit Homo-, Hetero- oder Doppelheteroübergängen.

Patentansprüche

1. Strahlungserzeugendes Halbleiterbauelement
 - mit einer aktiven Schicht (3) zwischen einer ersten Confinementschicht (2) und einer zweiten Confinementschicht (4) und
 - mit mindestens einem ersten Kontakt (5) und einem zweiten Kontakt (7) zum Anlegen eines Betriebsstromes, **dadurch gekennzeichnet,**
 - daß die von der aktiven Schicht (3) abgewandte Oberfläche der zweiten Confinementschicht (4) mit einer räumlichen periodischen Strukturierung versehen ist,
 - daß zumindest auf den mit dieser Strukturierung versehenen Bereich der Oberfläche der zweiten Confinementschicht (4) ein semitransparenter Metallfilm aufgebracht ist und
 - daß die Höhe (h) dieser Strukturierung und die Länge (Lg) jeweils einer Periode dieser Strukturierung, die Dicke (d4) der zweiten Confinementschicht (4) und die Dicke (d5) des Metallfilms so bemessen sind, daß im Betrieb des Halbleiterbauelementes an der der zweiten Confinementschicht (4) abgewandten Oberfläche des Metallfilms Oberflächenplasmonpolaritonen durch in der aktiven Schicht (3) erzeugte Photonen angeregt werden.
2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,** daß die räumliche periodische Strukturierung ein Gitter ist.
3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet,** daß das Gitter ein kantiges Profil hat.
4. Halbleiterbauelement nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet,** daß das Gitter ein gerundetes Profil hat.
5. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet,** daß die räumliche periodische Strukturierung eine Periodizität in zwei voneinander verschiedenen Richtungen aufweist.

6. Halbleiterbauelement nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß die räumliche periodische Strukturierung
ein Kreuzgitter ist. 5
7. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Metallfilm zumindest in Teilbereichen
mit einer Dielektrikumschicht (10) versehen ist 10
und daß die Dicke dieser Dielektrikumschicht
(10) so bemessen ist, daß im Betrieb des
Halbleiterbauelementes Oberflächenplasmon-
polaritonen in dieser Dielektrikumschicht (10)
angeregt werden. 15
8. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Metallfilm durch den ersten Kontakt (5) 20
gebildet wird.
9. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, 25
daß der Metallfilm durch zumindest einen An-
teil des ersten Kontakts (5) gebildet wird.
10. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, 30
dadurch gekennzeichnet,
daß die aktive Schicht (3) als Laserresonator
mit Resonatorendflächen (8) ausgebildet ist.
11. Halbleiterbauelement nach Anspruch 10, 35
dadurch gekennzeichnet,
- daß der erste Kontakt (5) als Streifenkon-
takt für den Laserresonator ausgebildet
ist,
- daß zumindest ein Anteil dieses ersten 40
Kontaktes (5) als ein semitransparenter
Metallfilm ausgebildet ist und
- daß dieser semitransparente Metallfilm
zumindest einen Teil der räumlichen pe-
riodischen Strukturierung bedeckt. 45

50

55

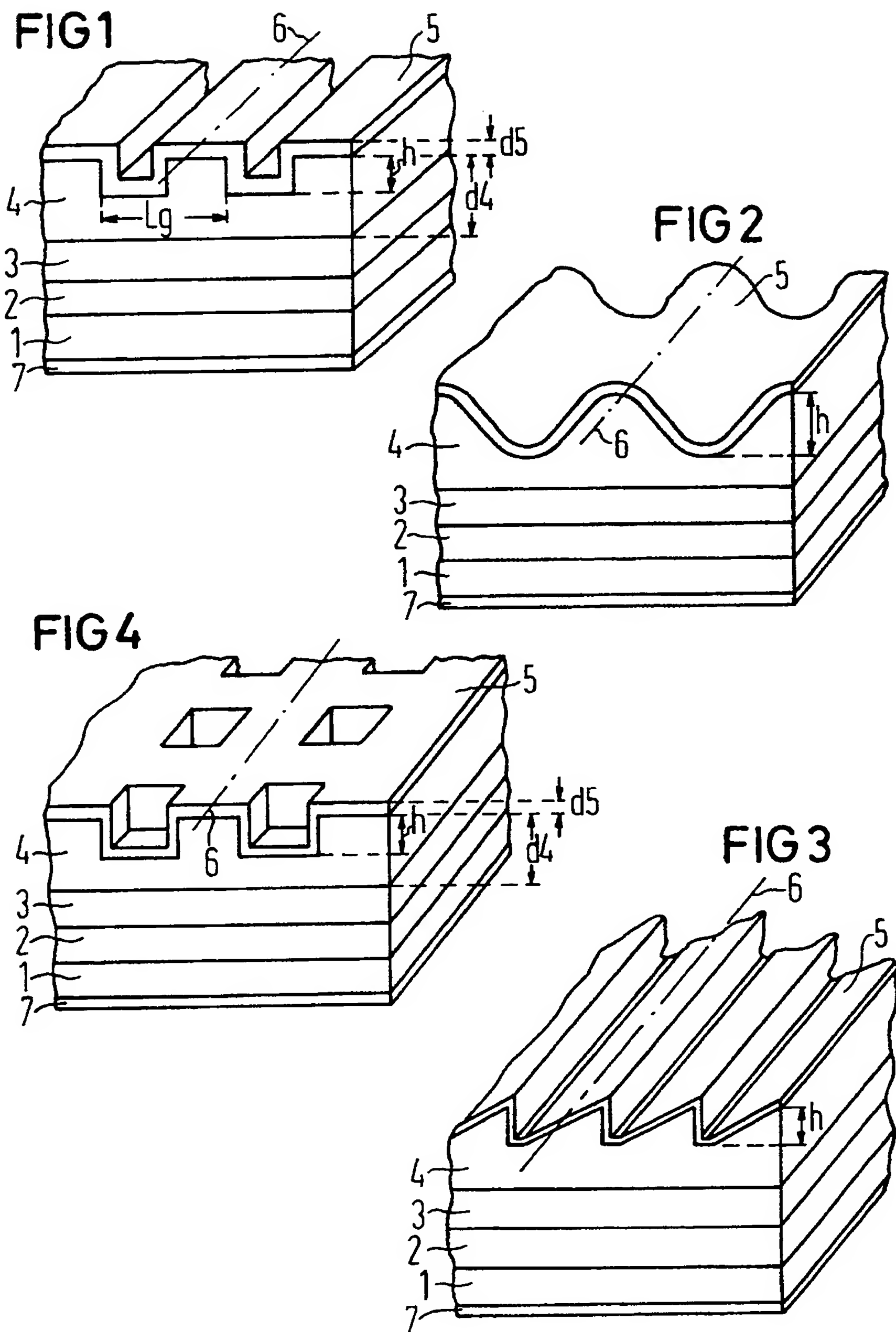


FIG5

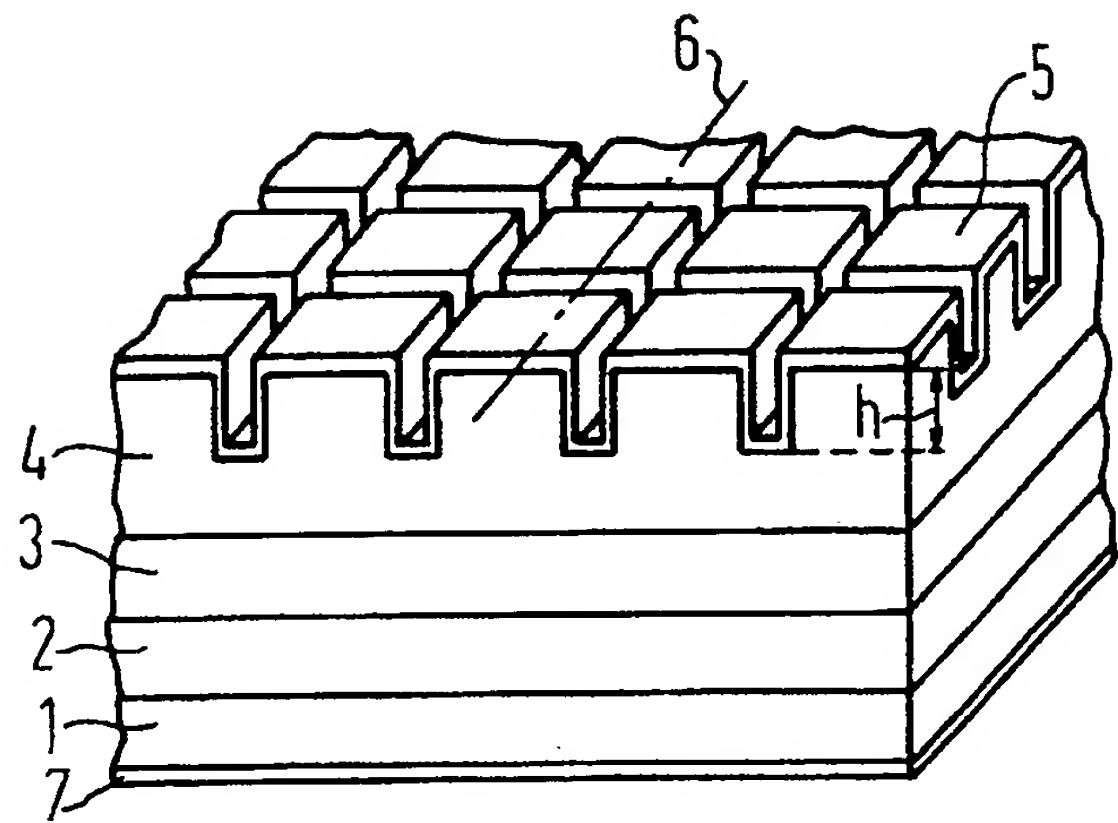


FIG6

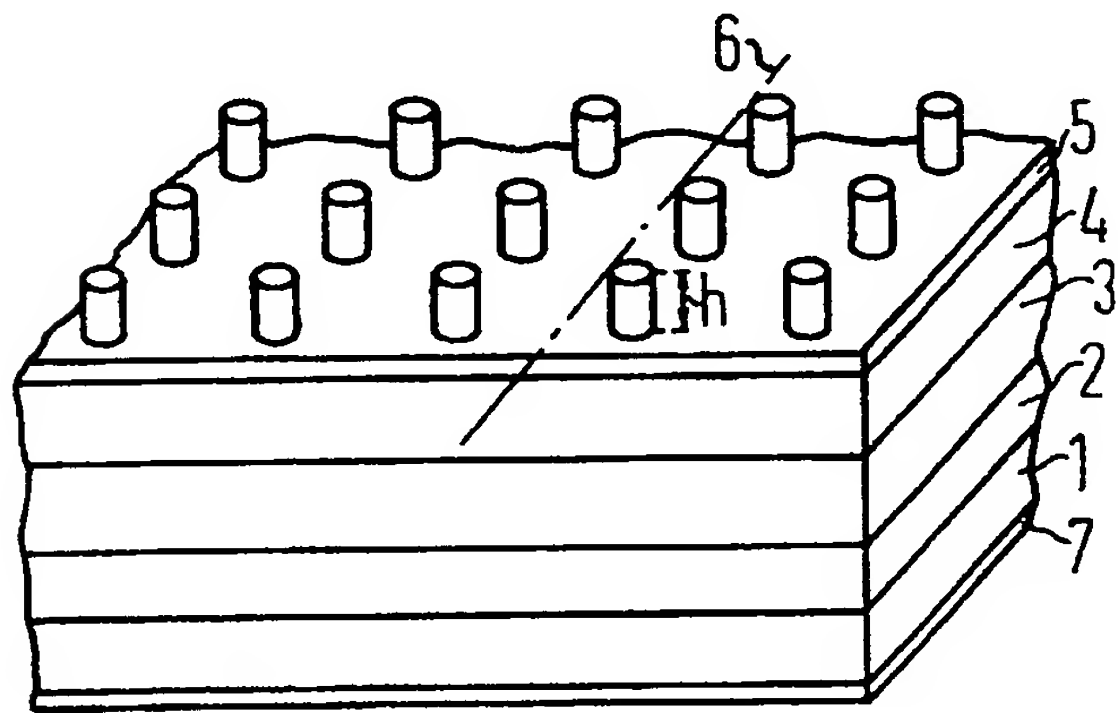


FIG7

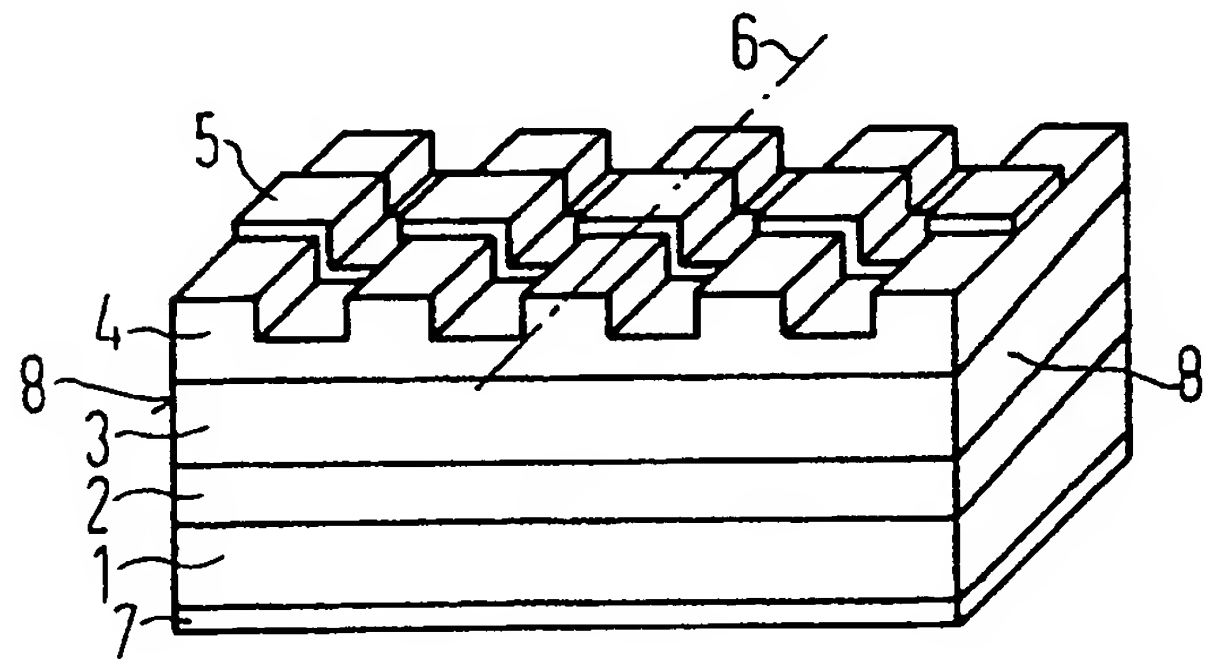


FIG 8

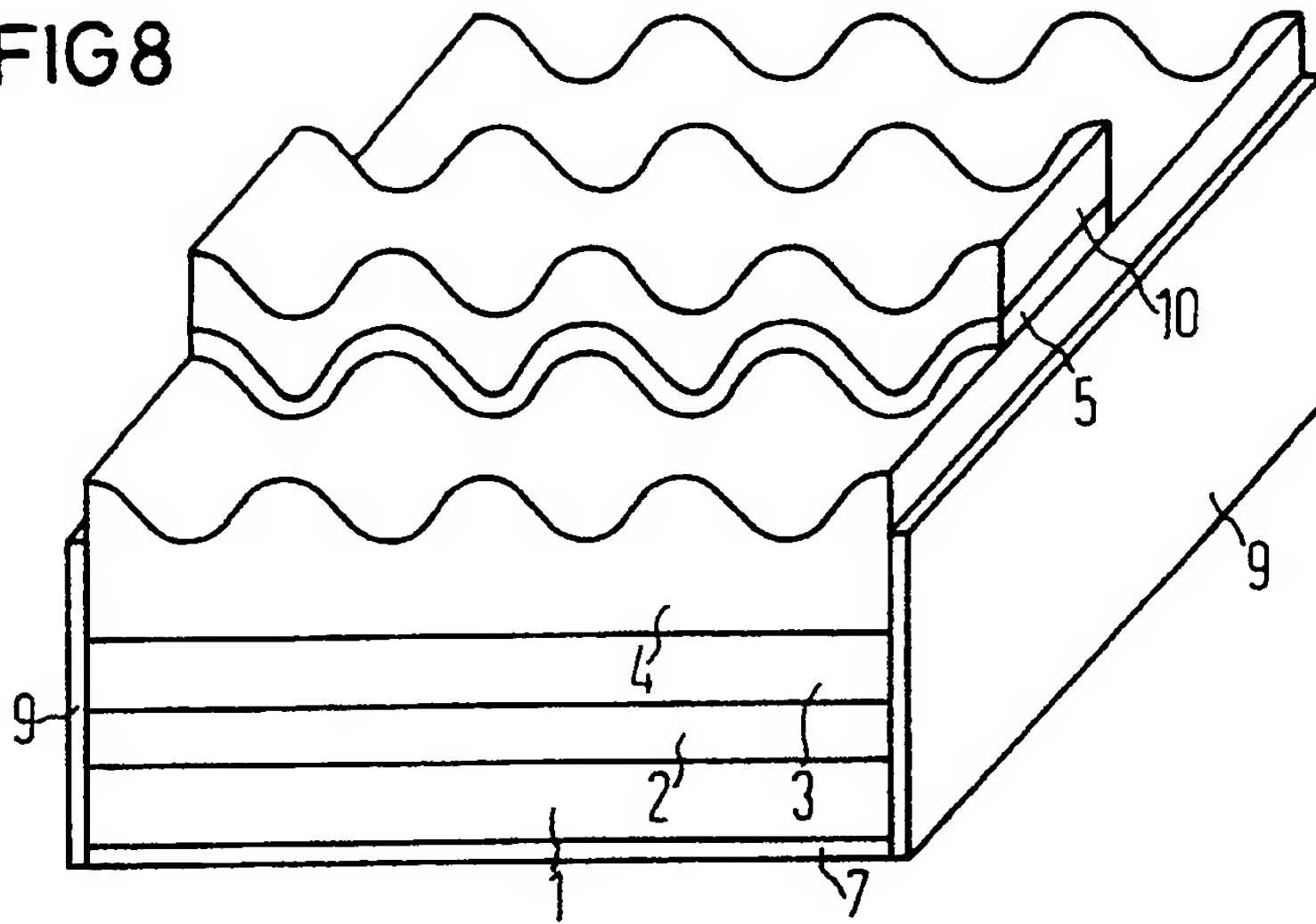


FIG 9

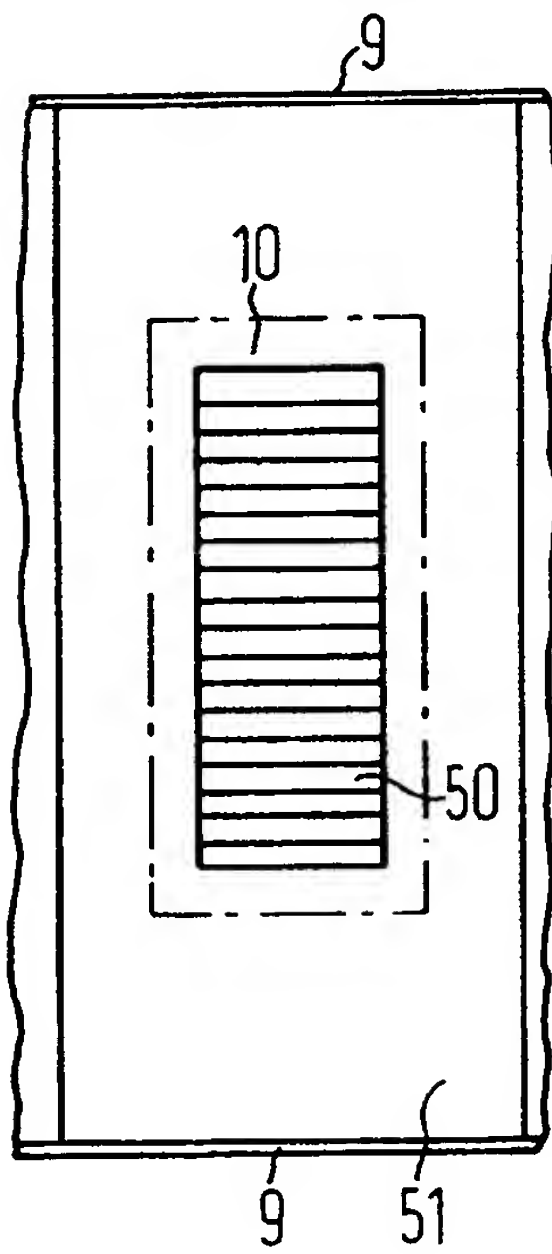


FIG 10

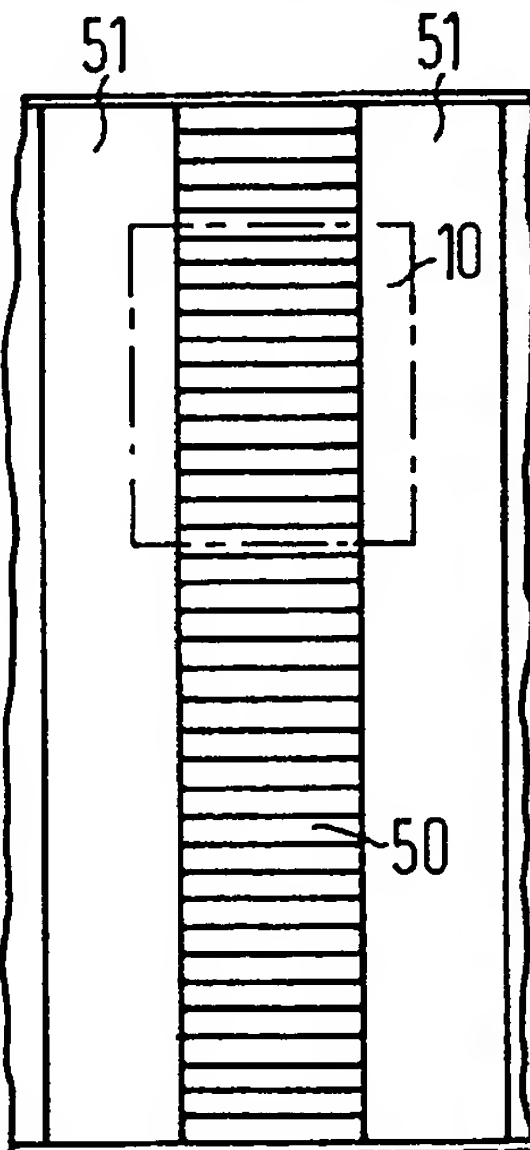


FIG 11

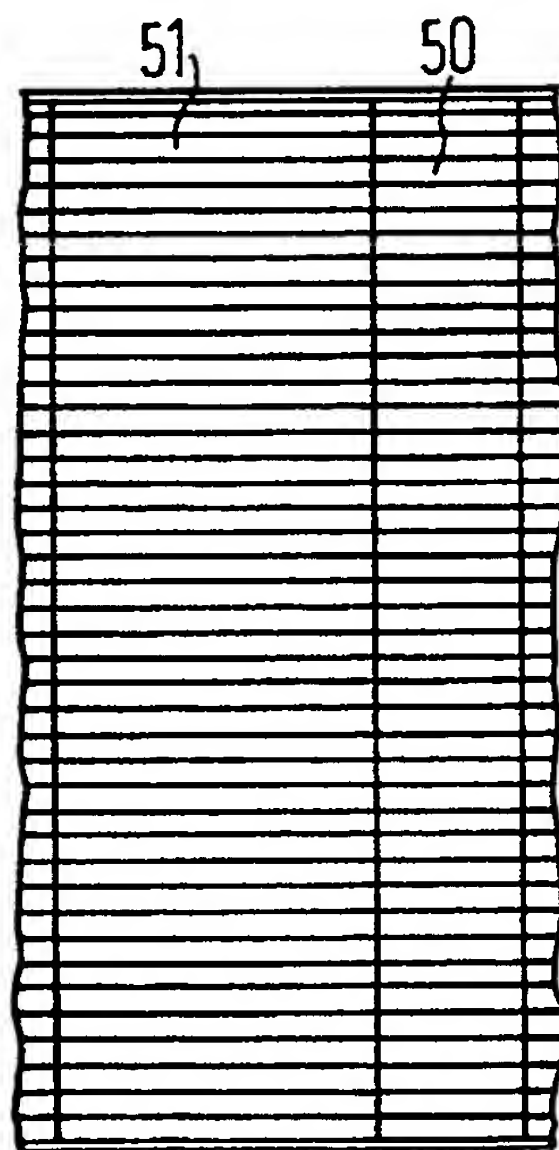
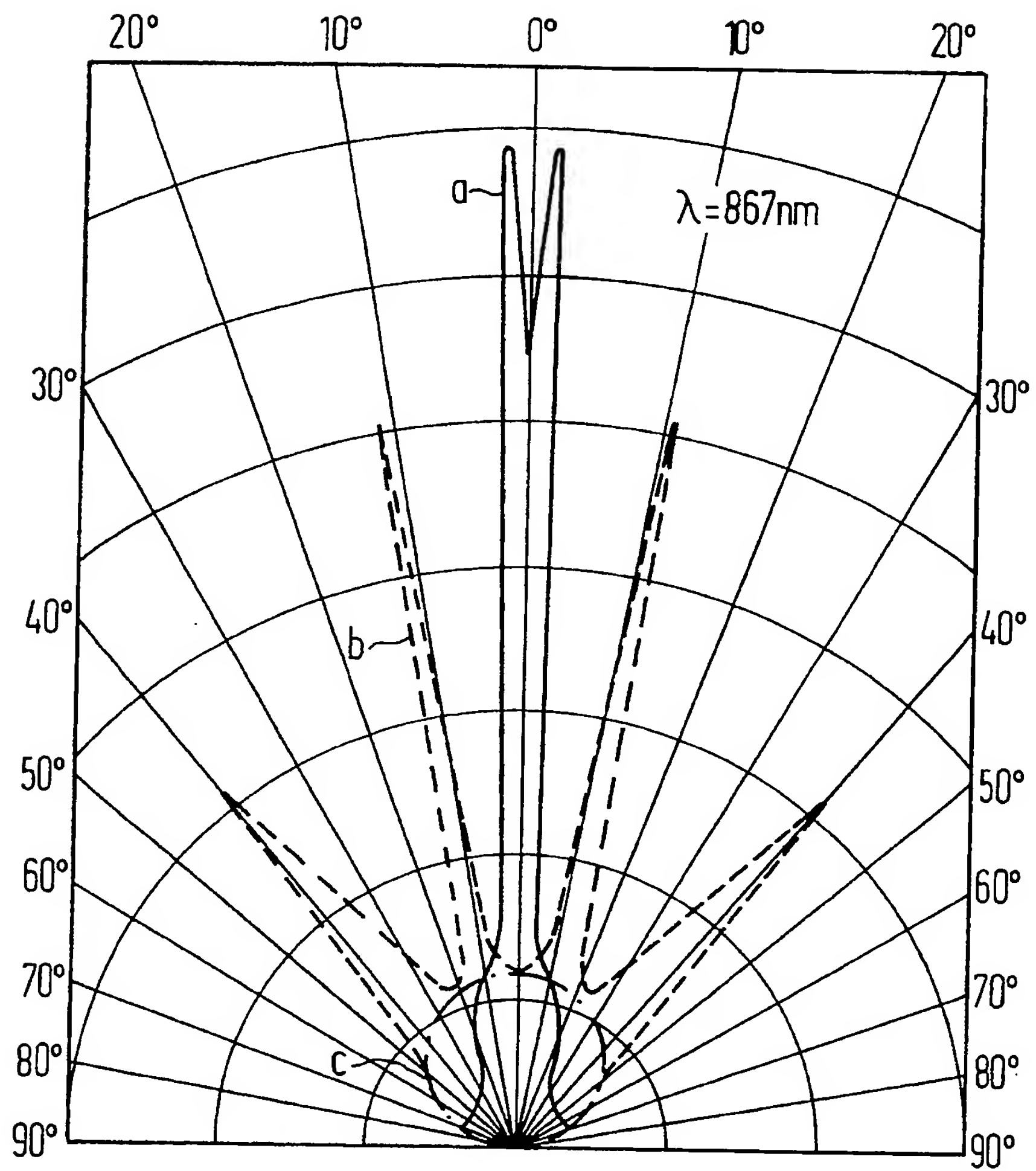


FIG 12





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 10 2816

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|---|---|---|--|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5) |
| A | ARCHIV FÜR ELEKTRONIK UND ÜBERTRAGUNGSTECHNIK. vol. 43, no. 6, November 1989, STUTTGART DE Seiten 388 - 389; ALFRED RAST: "A NOVEL InGaAsP/InP DISTRIBUTED FEEDBACK LASER WITH A CONTACTED SURFACE GRATING FOR $\lambda=1.55$ MICROMETERS" * das ganze Dokument * | 1-3, 10, 11 | H01L33/00 H01S3/06 |
| A | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 9, no. 102 (E-312)(1825) 04 Mai 1985, & JP-A-59 229891 (FUJITSU K.K.) 24 Dezember 1984, * das ganze Dokument * | 1-3, 10, 11 | |
| A | EP-A-334209 (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT) * Ansprüche ; Figur 4 * | 1, 2, 5 | |
| A | EP-A-309744 (SIEMENS AG) * Ansprüche ; Figuren * | 1 | |
| A | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 8, no. 139 (E-253)(1576) 28 Juni 1984, & JP-A-59 48975 (NIPPON DENKI K.K.) 21 März 1984, * das ganze Dokument * | 1 | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5) |
| A | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. vol. 66, no. 4, 15 August 1989, NEW YORK US Seiten 1544 - 1548; M.KUIJK ET AL.: "OPTICAL PLASMA RESONANCE IN SEMICONDUCTORS : NOVEL CONCEPTS FOR MODULATING FAR INFRARED LIGHT " | | H01L H01S |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | |
| Recherchemort | Abschlußdatum der Recherche | | Prüfer |
| DEN HAAG | 20 SEPTEMBER 1990 | | LINA F. |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE | | I : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze F : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument | |
| X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur | | | |

EPO FORM 150 (3.87 (P0403))